

L2SC3357 NPN TRANSISTOR

MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

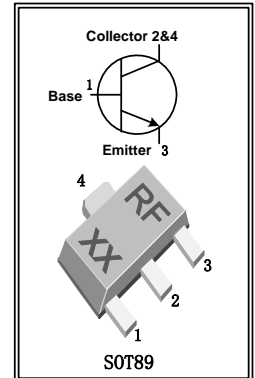
1. 简述:

本芯片采用双极硅外延工艺制造，具有高功率增益放大以及低噪声特性，大动态范围，理想的电流线性；

主要应用于超高频微波、VHF、UHF 和 CATV 等产品上的高频宽带低噪声放大器；

集电极-发射极击穿电压： $BV_{CEO}=15V$ ，最大集电极电流： $I_C=300mA$ ；最大集电极耗散功率： $P_C=1200mW$ ，特征频率： $f_T=6.5GHz$ ；

封装形式：SOT89，直流放大倍数对应本体印字：



CLASSIFICATION OF h_{FE}

Range	80 ~ 160
Marking	RF

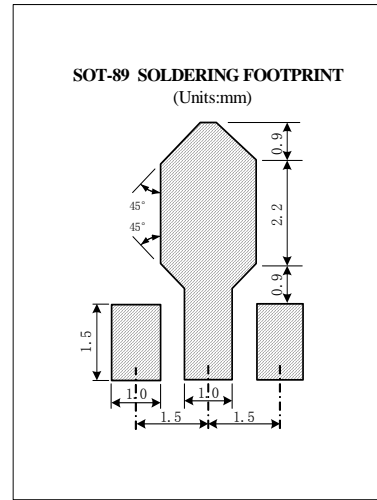
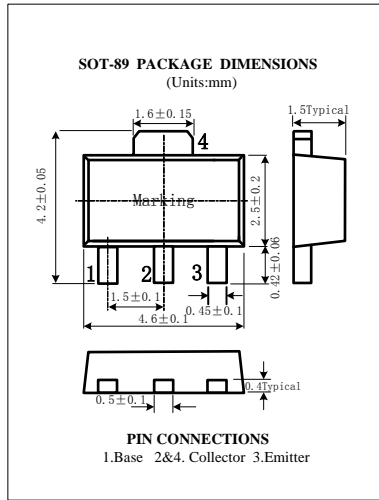
2. 极限参数 ($T_{amb}=25^{\circ}C$) :

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	20	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	15	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	3	V
集电极电流	I_C	300	mA
耗散功率	P_T	1200	mW
最高结温	T_J	150	$^{\circ}C$
储存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^{\circ}C$

3. 电参数及规格 ($T_{amb}=25^{\circ}C$) :

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=10V, I_E=0$	-	-	1.0	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=1.0V, I_C=0$	-	-	1.0	μA
直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$	80	120	160	
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$	-	6.5	-	GHz
噪声系数	NF	$V_{CE}=10V, I_C=7mA, f=1.0GHz$	-	1.1	-	dB
		$V_{CE}=10V, I_C=40mA, f=1.0GHz$	-	1.8	3.0	dB
反馈电容	C_{re}	$I_C=I_c=0, V_{CB}=10V, f=1MHz$	-	0.65	1.0	pF
插入功率增益	$ S_{21} ^2$	$I_C=20mA, V_{CE}=10V, f=1GHz$	-	9	-	dB

4. 封装尺寸示意图:



5. 包装信息:

PACKAGE INFORMATION

型号 TYPE	封装形式 Package	数量/盘带 Shipping	盘/中盒 Inner Box	中盒/箱 Carton
L2SC3357	SOT89	1000/Tape&Reel	4 Tape&Reel	8 Inner Box